

Полученный вывод об уменьшении скорости межуровневой релаксации с помощью магнитного поля имеет важное значение, поскольку указывает на возможность повышения квантового выхода источников длинноволнового электромагнитного излучения, использующих электронные переходы между уровнями размерного квантования.

Авторы благодарят С. Д. Сучалкина за помощь в вычислениях.

Список литературы

- [1] Мартисов М. Ю., Шик А. Я. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 6. С. 1075—1079.
- [2] Иогансен Л. В. // ЖЭТФ. 1966. Т. 50. В. 3. С. 709—716.
- [3] Гантмахер В. Ф., Левинсон И. Б. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. М., 1984. 351 с.
- [4] Мартисов М. Ю., Шик А. Я. // ФТП. 1988. Т. 21. В. 8. С. 1474—1477.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Санкт-Петербург

Получено 12.05.1991
Принято к печати 17.05.1991

ФТП, том 25, вып. 9, 1991

ИСПРАВЛЕНИЯ К СТАТЬЕ

«Некоторые особенности динамики ННЗ в кристаллах кремния
при сильном оптическом возбуждении»

(ФТП. 1991. Т. 25. В. 2. С. 344—347)

Пятраускас М., Норейка Д., Нятикшис В., Банайтис А.

По вине авторов в статье допущены некоторые неточности.

На стр. 344 (4-я строка снизу) не определено сокращение ННЗ.
ННЗ — неравновесные носители заряда.

На стр. 347 (4-я строка сверху) не определено сокращение ЛДХ.
ЛДХ — люкс-дифракционная характеристика, т. е. зависимость дифракционной эффективности от интенсивности возбуждения.

Вильнюсский университет

Получено 1.10.1991